

Физика и техника полупроводников, 2018, том 52, выпуск 11

К столетию Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе

- 1255
- XXII Международный симпозиум "Нанозонная физика и наноэлектроника", Нижний Новгород, 12-15 марта 2018 г.**
Козлов Д.В., Румянцев В.В., Морозов С.В., Кадыков А.М., Фадеев М.А., Hubers H.-W., Гавриленко В.И.
- XXII Международный симпозиум "Нанозонная физика и наноэлектроника", Нижний Новгород, 12-15 марта 2018 г. Расчет состояний многозарядных примесно-дефектных центров в эпитаксиальных слоях $Hg_{1-x}Cd_xTe$**
- 1257
- Румянцев В.В., Куликов Н.С., Кадыков А.М., Фадеев М.А., Иконников А.В., Казаков А.С., Жолудев М.С., Алешкин В.Я., Уточкин В.В., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А., Морозов С.В., Гавриленко В.И.
Влияние особенностей зонного спектра на характеристики стимулированного излучения в узкозонных гетероструктурах с квантовыми ямами на основе $HgCdTe$
- 1263
- Хабибуллин Р.А., Щаврук Н.В., Пономарев Д.С., Ушаков Д.В., Афоненко А.А., Васильевский И.С., Зайцев А.А., Данилов А.И., Волков О.Ю., Павловский В.В., Маремьянин К.В., Гавриленко В.И.
Температурная зависимость порогового тока и выходной мощности квантово-каскадного лазера с частотой генерации 3.3 ТГц
- 1268
- Бовкун Л.С., Маремьянин К.В., Иконников А.В., Спиринов К.Е., Алешкин В.Я., Potemski M., Piot B., Oglita M., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А., Гавриленко В.И.
Магнитооптика квантовых ям на основе $HgTe/CdTe$ с гигантским расщеплением Рашбы в магнитных полях до 34 Тл
- 1274
- Абрамкин Д.С., Бакаров А.К., Гутаковский А.К., Шамирзаев Т.С.
Спинодальный распад в $InSb/AlAs$ -гетероструктурах
- 1280
- Калентьева И.Л., Вихрова О.В., Данилов Ю.А., Звонков Б.Н., Кудрин А.В., Антонов И.Н.
Влияние состава газа-носителя в процессе роста дельта-слоя Mn на электрические и магнитные свойства $GaAs$ -структур
- 1286
- Гудина С.В., Боголюбский А.С., Неверов В.Н., Шелушинина Н.Г., Якунин М.В.
Модель петли экстремумов для спектра валентной зоны квантовой ямы $HgTe/HgCdTe$ с инвертированной зонной структурой в полуметаллической фазе
- 1291
- Пузанов А.С., Оболенский С.В., Козлов В.А.
Применение локально-неравновесной диффузионно-дрейфовой модели Каттанео-Вернотта для описания релаксации фототока в диодных структурах при воздействии субпикосекундных импульсов ионизирующих излучений
- 1295
- Юнин П.А., Дроздов Ю.Н., Хрыкин О.И., Григорьев В.А.
Исследование анизотропии структурных свойств слоев $(0001)GaN$, выращенных методом МОГФЭ на а-срезах сапфира $(11\bar{2}0)$
- 1300
- Цырлин Г.Э., Резник Р.Р., Самсоненко Ю.Б., Хребтов А.И., Котляр К.П., Илькив И.В., Сошников И.П., Кириленко Д.А., Крыжановская Н.В.
Нитевидные нанокристаллы на основе фосфидных соединений, полученные методом молекулярно-пучковой эпитаксии на поверхности кремния
- 1304
- Морозов К.М., Иванов К.А., Selenin N., Mikhlin S., de Sa Pereira D., Menelaou C., Monkman A.P., Калитеевский М.А.
Экспериментальное исследование усиления спонтанной эмиссии в микрорезонаторах на основе таммовских плазмонов с органической активной областью
- 1308
- Новодворский О.А., Михалевский В.А., Гусев Д.С., Лотин А.А., Паршина Л.С., Храмова О.Д., Черобыло Е.А., Дровосеков А.Б., Рыльков В.В., Николаев С.Н., Черноглазов К.Ю., Маслаков К.И.
Модификация ферромагнитных свойств тонких пленок $Si_{1-x}Mn_x$, синтезируемых методом импульсного лазерного осаждения при изменении давления буферного газа
- 1313
- Резник Р.Р., Котляр К.П., Илькив И.В., Сошников И.П., Лебедев С.П., Лебедев А.А., Кириленко Д.А., Алексеев П.А., Цырлин Г.Э.
Синтез методом молекулярно-пучковой эпитаксии и структурные свойства GaP - и InP -нитевидных нанокристаллов на SiC -подложке с пленкой графена

Юнин П.А., Волков П.В., Дроздов Ю.Н., Колядин А.В., Королев С.А., Радищев Д.Б., Суровегина Е.А., Шашкин В.И. Исследование структурных и морфологических свойств НРНТ алмазных подложек	1317
Деребезов И.А., Гайслер В.А., Гайслер А.В., Дмитриев Д.В., Торопов А.И., von Helversen M., de la Haye C., Bounouar S., Reitzenstein S. Спектроскопия одиночных AlInAs- и (111)InGaAs-квантовых точек	1321
Новиков А.В., Юрасов Д.В., Морозова Е.Е., Скороходов Е.В., Вербус В.А., Яблонский А.Н., Байдакова Н.А., Гусев Н.С., Кудрявцев К.Е., Нежданов А.В., Машин А.И. Формирование и исследование локально-растянутых Ge-микроструктур для кремниевой фотоники	1326
Павельев Д.Г., Васильев А.П., Козлов В.А., Оболенская Е.С. Радиационная стойкость терагерцовых диодов на основе GaAs/AlAs-сверхрешеток	1331
Рудин С.А., Смагина Ж.В., Зиновьев В.А., Новиков П.Л., Ненашев А.В., Родякина Е.Е., Двуреченский А.В. Зарождение трехмерных островков Ge на структурированной поверхности Si(100)	1337
Жуков А.Е., Гордеев Н.Ю., Шерняков Ю.М., Паюсов А.С., Серин А.А., Кулагина М.М., Минтаиров С.А., Калюжный Н.А., Максимов М.В. Снижение внутренних потерь и теплового сопротивления в лазерных диодах со связанными волноводами	1346
Добрецова А.А., Квон З.Д., Брагинский Л.С., Энтин М.В., Михайлов Н.Н. Подвижность и квантовое время бесщелевых дираковских электронов в квантовых ямах HgTe	1351
Охапкин А.И., Юнин П.А., Дроздов М.Н., Краев С.А., Скороходов Е.В., Шашкин В.И. Плазмохимическое травление арсенида галлия в индуктивно-связанной плазме C₂F₅Cl	1357
Хананова А.В., Оболенский С.В. Разработка физико-топологической модели реакции мощного вертикального ДМОП транзистора на воздействие импульсного гамма-излучения	1362
Абрамкин Д.С., Петрушков М.О., Путято М.А., Семягин Б.Р., Шамирзаев Т.С. Гетероструктуры с InAs/AlAs квантовыми ямами и квантовыми точками, выращенные на гибридных подложках GaAs/Si	1366
Дроздов Ю.Н., Хрыкин О.И., Юнин П.А. Проверка гипотезы о термоупругом характере деформации слоя (0001)GaN, выращенного на а-срезе сапфира	1373
Кудрявцев К.Е., Дубинов А.А., Алешкин В.Я., Юрасов Д.В., Горлачук П.В., Рябоштан Ю.Л., Мармалюк А.А., Новиков А.В., Красильник З.Ф. Стимулированное излучение в диапазоне 1.3-1.5 мкм из квантовых ям AlGaInAs в гибридных светоизлучающих структурах A^{III}B^V на кремниевых подложках	1380
Бекин Н.А. Многофононная внутрицентровая релаксация состояний акцепторов бора в алмазе	1384
	1390